



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 پهن باند با سرعت بالا مبتنی بر موجبر هایبرید پلاسمونیک

بابک جانجان، عباس ظریفکار و عباس علی قنبری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده - در این مقاله سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 پهن باند با سرعت سوئیچینگ بسیار زیاد بر پایه تزویجر برای استفاده در اتصالات قابل پیکربندی مجدد در شبکه‌های نوری ارائه می‌شود. موجبرهای استفاده شده در تزویجر، موجبرهای هایبرید پلاسمونیک هستند که امکان نوینی را برای مجتمع سازی پلیمرهای الکترواپتیک در فناوری سیلیکن فراهم می‌کنند. سرعت سوئیچینگ محاسبه شده در حدود ۴ پیکو ثانیه است. سطح هم‌شنوایی در پهنای باند ۸۷ نانومتری سوئیچ کمتر از -18 dB است.

کلید واژه - تزویجر، سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 ، موجبر هایبرید پلاسمونیک

Broadband and high-speed 2×2 electro-optic switch based on hybrid plasmonic waveguide

Babak Janjan, Abbas Zarifkar, and Abbas Ali-Ghanbari

School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz

Abstract-in this article, we present a broadband and high-speed 2×2 electro-optic switch based on directional coupler for reconfigurable interconnection applications in optical network. The used waveguides are hybrid plasmonic waveguides which provide new possibilities for integrating of polymer electro-optic materials in silicon technology. Switching time is 4 ps and optical crosstalk levels lower than -18 dB are obtained for an optical bandwidth of 87 nm.

Keywords: 2×2 Electro-optic switch, coupler, on-chip optical network

۱- مقدمه

پرسرعت نوری بکار می‌روند، با فناوری سیلیکن بسیار مشکل است. موجبرهای پلاسمونیک امکان جدیدی برای مجتمع سازی پلیمرهای الکترواپتیک در فناوری سیلیکن فراهم کرده‌اند [۹].

سوئیچ نوری 2×2 پهن‌بند یک قطعه کلیدی برای شبکه‌های نوری درون تراشه محسوب می‌شود زیرا المان پایه‌ای برای ماتریس سوئیچینگ هستند که به طور همزمان همه کانال‌های WDM را مسیر دهی می‌کنند. پهنای باند این سوئیچ‌ها بطور مستقیم تعداد و فاصله کانال‌های WDM را مشخص می‌کند [۲]. بطور کلی سرعت سوئیچینگ بالا و اندازه کوچک از ویژگی‌های کلی این سوئیچ‌ها هستند.

در این مقاله سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 پهن‌بند با سرعت بسیار زیاد برپایه تزویجگر و موجبرهای هایبرید پلاسمونیک برای شبکه‌های نوری درون تراشه ارائه می‌شود که از پلیمر الکترواپتیک در آن استفاده شده است. در ادامه در بخش ۲، ساختار سوئیچ پیشنهادی، ارائه شده و در بخش ۳ چگونگی طراحی آن تشریح می‌گردد. در بخش ۴ نتایج شبیه سازی سوئیچ و مشخصات آن ارائه می‌شود و نهایتاً در بخش ۵ جمع‌بندی لازم بیان می‌شود.

۲- ساختار

در شکل ۱ ساختار سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 بر مبنای موجبر هایبرید پلاسمونیک نشان داده شده است. در ساختار تزویجگر از دو موجبر هایبرید پلاسمونیک یکسان استفاده شده است. مرز نیم دایره‌ای نقش کلیدی در ساختار موجبر هایبرید پلاسمونیک ایفا می‌کند زیرا باعث افزایش طول انتشار موجبر می‌شود [۵]. اندازه‌های در نظر گرفته شده در این مقاله عبارتند از: $w=250 \text{ nm}$, $hg=50 \text{ nm}$ و $hsi=400 \text{ nm}$, $hr=50 \text{ nm}$, $hm=100 \text{ nm}$

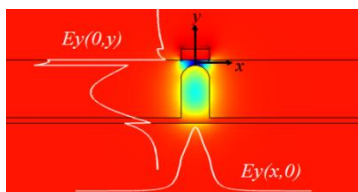
مقدار ضریب شکست SiO_2 و Si که مقدار 10^{18} cm^{-3} ناخالصی بور برای ایجاد اتصال الکتریکی به آن اضافه شده در طول موج $1/55 \mu\text{m}$ به ترتیب برابر $1/444$ و $10^{-6} \times 3,476 + 7,4 \times 10^{-6}$ در نظر گرفته شده‌اند. همچنین وابستگی آنها به طول موج در شبیه‌سازی اعمال شده است [۱۳]. ضریب شکست نقره با استفاده از مدل درود-

اتصالات الکتریکی بر پایه فلزات محدودیت‌های بسیاری در زمینه‌هایی مانند نرخ داده، پهنای باند، توان مصرفی و ... در سامانه‌های پردازش موازی با حجم بسیار بالا ایجاد می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود که با اتصالات نوری پهن‌بند با توان مصرفی کم جایگزین شوند [۱]. معماری شبکه‌های نوری درون تراشه که مسیرهای ارتباطی قابل پیکربندی مجدد را بین هسته‌ی پردازشگر و حافظه در درون تراشه فراهم می‌کنند، طی سالهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است [۲].

یکی از مشکلات عمده گسترش شبکه‌های نوری، محدودیت حد پراش (محدودیت اندازه‌ی ادوات نوری به وسیله طول موج نور حمل شده توسط شبکه) است که باعث بزرگتر شدن اندازه ادوات نوری در مقایسه با ادوات الکترونیکی می‌شود. حد پراش را می‌توان با بهره‌گیری از پلاسمونیک شکست [۳]. موجبرها که المان پایه‌ای برای فوتونیک محسوب می‌شوند، در این حوزه بسیار متنوع هستند ولی موجبرهای هایبرید پلاسمونیک به دلیل فراهم کردن تعادل مناسب بین طول انتشار و سطح موثر مد، توجه بیشتری را بسوی خود معطوف داشته‌اند [۴, ۵]. در این بین موجبرهای هایبرید پلاسمونیک بر پایه سیلیکن ویژگی‌های منحصر به فردی را ارائه می‌کنند. این موجبرها بخصوص بر پایه فناوری پیشرفته سیلیکن روی عایق (SOI) ساخته می‌شوند و از همه مهمتر می‌توان با تلفات کم، آنها را به موجبرهای دی‌الکتریک SOI متصل کرد [۶]. تاکنون ادوات نوری بسیاری مانند خم [۶]، قطبشگر [۷]، چرخاننده قطبش [۸] تزویجگر [۵, ۹]، حلقه تشدید [۱۰] و سوئیچ [۹] بر پایه موجبر هایبرید پلاسمونیک ارائه شده‌اند.

مشکل دیگر، صفر بودن ضریب پاکلز سیلیکن است. هرچند اثراتی مانند اثر ترمواپتیک [۱۱] و اثر پاشندگی حامل‌های آزاد [۱۲] برای کنترل خواص نوری سیلیکن به صورت پویا بکار گرفته شده‌اند، اما این فناوری‌ها تاثیرات نامطلوبی روی سرعت، تلفات و ... دارد. مجتمع‌سازی پلیمرهای الکترواپتیک و LiNbO_3 که برای ساخت ادوات

سوئیچ

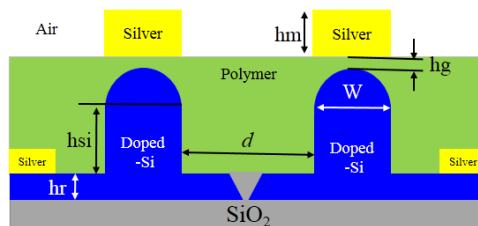


شکل ۲: توزیع میدان غالب E_y مد TM-like به همراه پروفایل میدان-های $E_y(x, 0)$ و $E_y(0, y)$ برای وضوح بیشتر

ابتدا با توجه با ولتاژ اعمالی، طول مورد نیاز برای ایجاد اختلاف فاز $\sqrt{3}\pi/2$ در هر یک از موجبرها طبق رابطه $L = \sqrt{3}\pi/4\Delta n_{eff}$ که تغییر ضریب شکست موثر موجبر هایبرید پلاسمونیک در اثر اعمال ولتاژ است، محاسبه می شود سپس طول محاسبه شده برابر یک طول تزویج تزویجگر در نظر گرفته می شود و با توجه به آن فاصله بین موجبرهای تزویجگر محاسبه می شود. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار COMSOL نشان داد که با اعمال ۲ ولت به یکی از موجبرهای هایبرید پلاسمونیک و ۲- ولت به موجبر دیگری، ضریب شکست موثر هر یک از موجبرها به ترتیب 0.00274 و 0.00266 تغییر می کند. بنابراین طول تزویج یا به عبارت دیگر طول کلی سوئیچ برابر با $249 \mu m$ محاسبه می شود که در مقایسه با مراجع [۱۷, ۱۶] به ترتیب ۱۲ و ۱۷ برابر کاهش پیدا کرده است. همچنین با توجه به طول تزویج فاصله بین دو موجبر برابر با $d = 595.4 \text{ nm}$ می باشد که همچنین این مقدار هم با توجه دو مرجع ذکر شده به بیشتر از ۵ برابر کاهش پیدا کرده است.

۴- نتایج شبیه سازی

طیف توان انتقالی سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 برای دو موجبر تزویجگر در حالت خاموش در شکل ۳-الف رسم شده است. فرض شده که توان ورودی به موجبر ۱ وارد می شود. همانطور که مشخص است در طول موج $1/55$ میکرومتر، سوئیچ در حالت cross است و با فاصله گرفتن از این طول موج مقدار توان خارج شده از موجبر ۲ در خروجی به دلیل وابستگی κ به طول موج کاهش می یابد. با در نظر گرفتن 20 dB به عنوان مرجع برای پهنای باند که با نقطه چین بر روی شکل نشان داده شده است، مقدار پهنای باند سوئیچ در حالت خاموش برابر با 87



شکل ۱: ساختار سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2

موج $1/55 \mu m$ برابر با $n_{Ag} = 0.146 + j11.327$ است [۱۴]. همچنین ضریب شکست و پاکلز پلیمر به ترتیب برابر $1/7$ و 300 pV/m در نظر گرفته شده اند [۱۵].

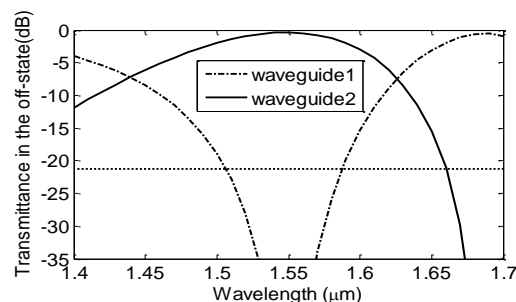
توزیع میدان الکتریکی غالب E_y برای مد TM-like موجبر هایبرید پلاسمونیک شبیه سازی شده به وسیله نرم افزار COMSOL در شکل ۲ نشان داده شده است. همچنین برای وضوح بیشتر پروفایل میدانهای $E_y(x, 0)$ و $E_y(0, y)$ رسم شده اند. با توجه به پروفایل $E_y(0, y)$ مشخص است که بیشتر میدان الکتریکی در داخل لایه پلیمری قرار گرفته شده بین نقره و سیلیکن جای گرفته و مقداری هم در داخل هسته سیلیکنی باقی مانده است. بنابراین با اعمال ولتاژ به پلیمر می توان سیگنال نوری را مدوله کرد.

۳- طراحی سوئیچ نوری

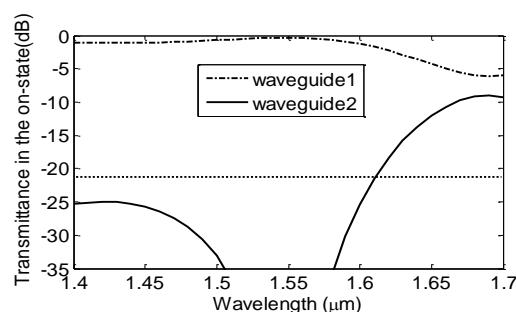
چنانچه موجبرهای یک تزویجگر یکسان باشند توان بصورت کامل بین دو موجبر معاوضه می شود (حالت cross). طول تزویج برای انتقال کامل توان از یک موجبر به موجبر دیگر برابر با $L_c = \pi/2\kappa$ است که در آن κ ضریب تزویج می باشد. حال برای اینکه در یک طول تزویج در خروجی تزویجگر، معاوضه توان وجود نداشته باشد یا به عبارت دیگر، توان از همان موجبری که وارد شده، خارج شود، باید اختلاف فازی برابر با $\sqrt{3}\pi$ بین دو موجبر تزویجگر ایجاد شود (حالت bar). بنابراین با در نظر گرفتن طول تزویجگر به اندازه یک طول تزویج و اعمال اختلاف فاز $\sqrt{3}\pi$ بین موجبرهای آن می توان عمل سوئیچینگ را در خروجی انجام داد یا به عبارت دیگر از تزویجگر به عنوان سوئیچ نوری استفاده کرد [۱۶].

در طراحی این سوئیچ از روش پوش-پول استفاده شده که در آن اختلاف فاز برابر اما مختلف علامه $\sqrt{3}\pi/2$ به هر یک از دو موجبر اعمال می شود [۱۶]. برای طراحی

نانومتر است. با اعمال ولتاژ به الکترودها، سوئیچ از حالت bar به cross



(الف)



(ب)

شکل ۳: طیف توان انتقالی سوئیچ نوری الکترواپتیک ۲×۲ (الف) در حالت خاموش (ب) در حالت روشن

تغییر حالت می‌دهد. در این حالت طیف توان انتقالی سوئیچ نوری الکترواپتیک ۲×۲ به صورت شکل ۳-ب تغییر می‌کند. با توجه به شکل، پهنای باند سوئیچ در حالت روشن خیلی بیشتر از حالت خاموش است. بنابراین پهنای باند سوئیچ همان پهنای باند آن در حالت خاموش یعنی ۸۷ نانومتر است. مقدار حداکثر تلفات سوئیچ در پهنای باند آن در حدود ۲ dB و هم‌شناوبی آن کمتر از ۱۸ dB- است. سرعت سوئیچ با توجه به سرعت پاسخ‌دهی بالای پلیمر (در حدود فمتو ثانیه) به مقدار RC بستگی دارد [۹]. مقدار خازن و مقاومت به ترتیب برابر با ۲۰ fF و ۲۰۰ Ω محاسبه شده، بنابراین سرعت سوئیچ برابر با ۴ ps حاصل می‌گردد که در مقایسه با مرجع [۱۷] در حدود شش برابر کاهش نشان می‌دهد.

۵- نتیجه‌گیری

موجبرهای هایبرید پلاسمونیک که توانایی شکستن حد پراش را دارند امکان نوینی برای مجتمع سازی پلیمرهای الکترواپتیک در فناوری سیلیکن فراهم کرده‌اند. با استفاده

از تزویجگر ساخته شده به وسیله موجبرهای هایبرید پلاسمونیک به عنوان سوئیچ نوری می‌توان به سرعت سوئیچینگ بالا در حدود ۴ پیکو ثانیه با اعمال ولتاژ ± 2 ولت به صورت پوش-پول، دست یافت. سوئیچ هم‌شناوبی کمتر از ۱۸ dB- و تلفات ۲ dB در پهنای باند ۸۷ نانومتر با اندازه بسیار کوچکتر در مقایسه با سوئیچ‌های مشابه را نشان می‌دهد.

مراجع

- [۱] T. Barwicz, *et al.*, "Silicon photonics for compact, energy-efficient interconnects," *Journal of Optical Networking*, vol. ۶, pp. ۷۳-۷۳, ۲۰۰۷.
- [۲] A. Shacham, K. Bergman, and L. P. Carloni, "Photonic Networks-on-Chip for Future Generations of Chip Multiprocessors," *IEEE, Transactions on Computers*, vol. ۵۷, pp. ۱۲۴۶-۱۲۶۰, ۲۰۰۸.
- [۳] D. K. Gramotnev and S. I. Bozhevolnyi, "Plasmonics beyond the diffraction limit," *Nat. Photon*, vol. ۴, pp. ۸۲-۹۱, ۲۰۱۰.
- [۴] D. Dai and S. He, "A silicon-based hybrid plasmonic waveguide with a metal cap for a nano-scale light confinement," *Optics Express*, vol. ۱۷, pp. ۱۶۶۴۶-۱۶۶۵۳, ۲۰۰۹.
- [۵] A. Amirhosseini and R. Safian, "A Hybrid Plasmonic Waveguide for the Propagation of Surface Plasmon Polariton at ۱,۵۵ μm on SOI Substrate," *Transactions on Nanotechnology*, vol. ۱۲, pp. ۱۰۳۱-۱۰۳۶, ۲۰۱۳.
- [۶] M. Wu, Z. Han, and V. Van, "Conductor-gap-silicon plasmonic waveguides and passive components at subwavelength scale," *Optics Express*, vol. ۱۸, pp. ۱۱۷۲۸-۱۱۷۳۶, ۲۰۱۰.
- [۷] M. Z. Alam, J. S. Aitchison, and M. Mojahedi, "Compact and silicon-on-insulator-compatible hybrid plasmonic TE-pass polarizer," *Optics Letters*, vol. ۳۷, pp. ۵۵-۵۷, ۲۰۱۲.
- [۸] G. Linfei, *et al.*, "Ultra-Compact and Low-Loss Polarization Rotator Based on Asymmetric Hybrid Plasmonic Waveguide," *IEEE, Photonics Technology Letters*, vol. ۲۵, pp. ۲۰۸۱-۲۰۸۴, ۲۰۱۳.
- [۹] E. F. Dudley and P. Wounjhang, "Ultra-Compact High-Speed Electro-Optic Switch Utilizing Hybrid Metal-Silicon Waveguides," *Journal of Lightwave Technology*, vol. ۳۰, pp. ۳۴۰۱-۳۴۰۶, ۲۰۱۲.
- [۱۰] S. Zhu, G. Q. Lo, and D. L. Kwong, "Submicron-Radius Plasmonic Racetrack Resonators in Metal-Dielectric-Si Hybrid Plasmonic Waveguides," *IEEE, Photonics Technology Letters*, vol. ۲۶, pp. ۸۳۳-۸۳۶, ۲۰۱۴.
- [۱۱] M. Harjanne, *et al.*, "Sub-μ switching time in silicon-on-insulator Mach-Zehnder thermo-optic switch," *Photonics Technology Letters*, vol. ۱۶, pp. ۲۰۳۹-۲۰۴۱, ۲۰۰۴.
- [۱۲] R. A. Soref and B. R. Bennett, "Electrooptical effects in silicon," *Quantum Electronics, IEEE Journal of*, vol. ۲۳, pp. ۱۲۳-۱۲۹, ۱۹۸۷.
- [۱۳] E. D. Palik, *Handbook of Optical Constants of Solids*: Academic Press, ۱۹۹۸.
- [۱۴] P. B. Johnson and R. W. Christy, *Optical Constants of the Noble Metals*: Dartmouth College., ۱۹۷۲.
- [۱۵] T. D. Kim, *et al.*, "Ultralarge and Thermally Stable Electro-Optic Activities from Supramolecular Self-Assembled Molecular Glasses," *Journal of the American Chemical Society*, vol. ۱۲۹, pp. ۴۸۸-۴۸۹, ۲۰۰۷.
- [۱۶] C. T. Zheng, *et al.*, "Simulation and optimization of a polymer directional coupler electro-optic switch with push-pull electrodes," *Optics Communications*, vol. ۲۸۱, pp. ۳۶۹۵-۳۷۰۲, ۲۰۰۸.

- [۱۷] C. T. Zheng, *et al.*, "Analysis of response characteristics for polymer directional coupler electro-optic switches," *Optics Communications*, vol. ۲۸۱, pp. ۵۹۹۸-۶۰۰۵, ۲۰۰۸.